

808nm G-Stack 阵列

产品简介

半导体激光器 G-Stack 阵列，采用 AuSn 硬焊料封装，具有高可靠性和长寿命等特点，可实现准连续高功率输出，产品多用于激光泵浦、激光切割、激光医疗等领域。

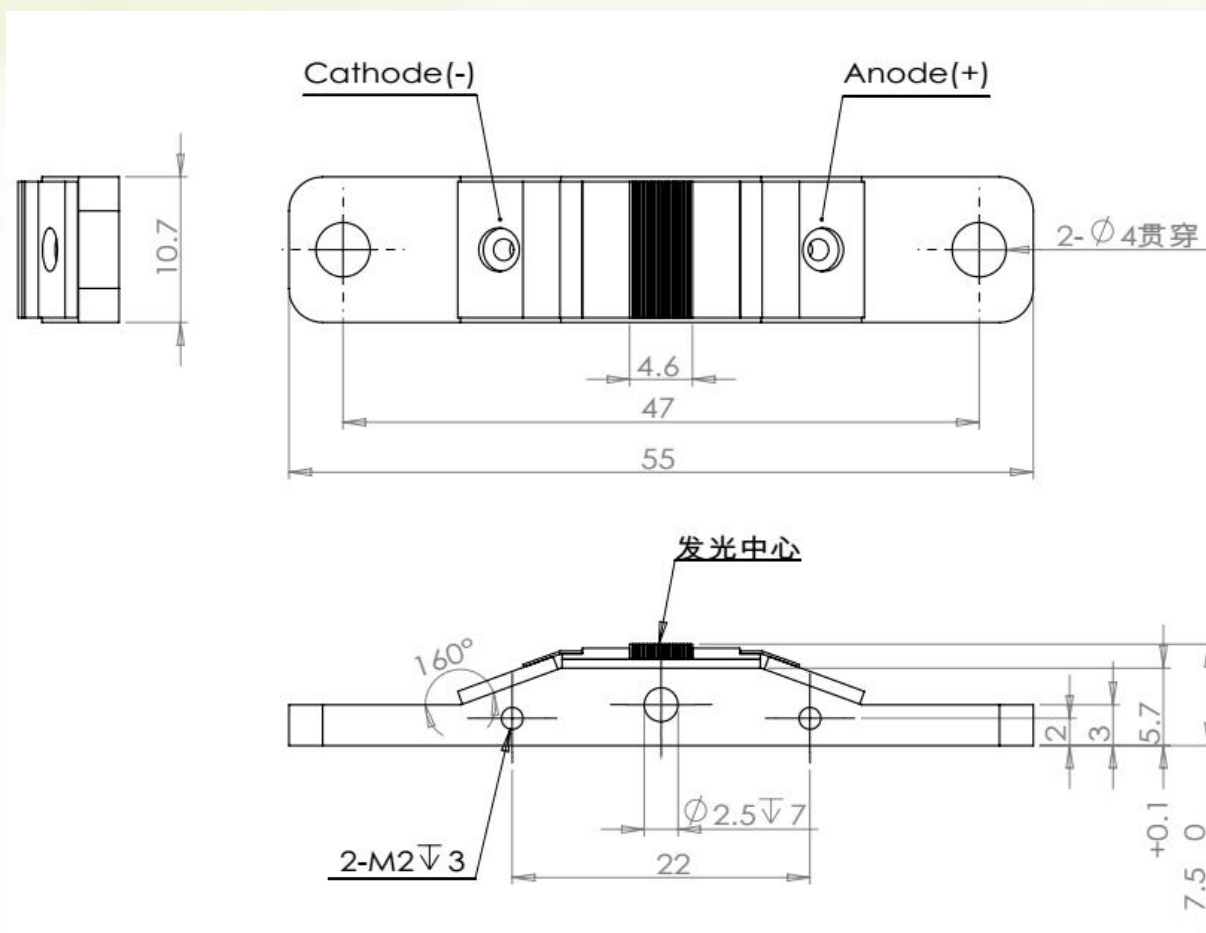


技术指标 (25°C)

G-Stack 阵列					
参数	单位	LDAQ2-0808-****			
光学参数	工作方式	-	QCW		
	中心波长	nm	808 ± 5		
	输出功率/Bar	W	100	200	300
	Bar 数量	条	4~20		
	Bar 间距	mm	0.4/0.8/1.2		
	光谱宽度	nm	< 5		
	波长温度系数	nm/°C	0.28		
	快轴发散角	deg	< 35		
	慢轴发散角	deg	< 10		
电学参数	占空比	%	≤ 3	≤ 4	≤ 4
	阈值电流	A	< 22	< 20	< 20
	工作电流	A	< 120	< 230	< 295
热学参数	工作电压	V	< 2.1	< 2.4	< 2.4
	推荐工作温度	°C	15 ~ 35		
	存储温度	°C	-10 ~ 60		



封装外形图



- 1、产品型号说明：LDAQ2（产品类型）-0808（中心波长）-****（输出功率）。
- 2、封装外形图仅供参考，可依据客户提供图纸进行封装。
- 3、请确保激光器工作在 15 ~ 35°C。在较高温度下工作，会增大阈值电流，降低转换效率，加速器件老化。
- 4、请在设计和使用过程中采取防结露措施，避免结露，结露将导致激光器迅速退化。
- 5、如有更多信息需求请联系海特光电有限责任公司。

